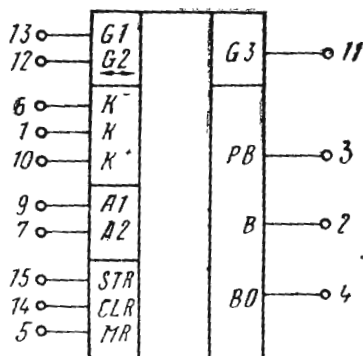


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 — вход контроля $K$                   | 9 — вход исключения триггера $A1$   |
| 2 — выход $B$                           | 10 — вход «плюс корректировки» $K+$ |
| 3 — выход предварительной команды $PB$  | 11 — выход инвертора $G3$           |
| 4 — выход делителя $BD$                 | 12 — вход/выход инвертора $G2$      |
| 5 — вход «сброс» $MR$                   | 13 — вход генератора $G1$           |
| 6 — вход «минус корректировки» $K-$     | 14 — вход «установка» $GLD$         |
| 7 — вход исключения двух триггеров $A2$ | 15 — вход «пуск» $STR$              |
| 8 — общий                               | 16 — +5 В                           |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 10^\circ\text{C}$ )

Напряжение питания, В . . . . .	$5 \pm 20\%$
Ток потребления, мкА, не более:	
в динамическом режиме . . . . .	100
в статическом режиме при высоком (низком) уровне выходного напряжения . . . . .	20
Выходное напряжение, В:	
низкого уровня, не более . . . . .	0,4
высокого уровня, не менее . . . . .	$0,9 U_n$

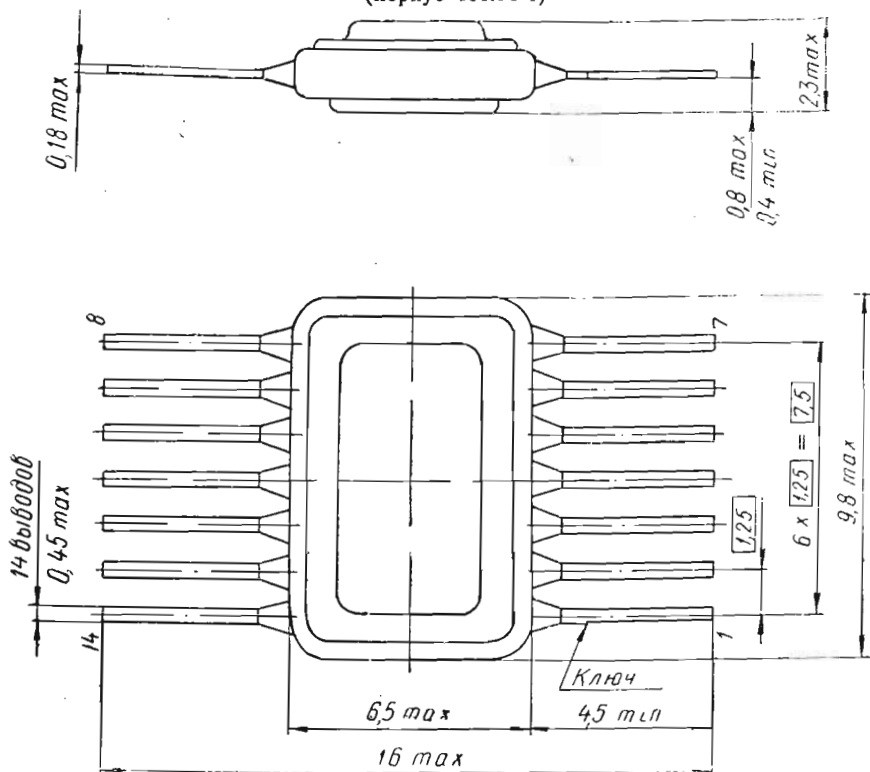
Предельно допустимые значения параметров в режимах эксплуатации

Напряжение питания, В:	
максимальное . . . . .	9
минимальное . . . . .	3
Максимальный ток в динамическом режиме, мкА . . . . .	400
Максимальная частота, кГц . . . . .	150

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 512

## Общие данные

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (корпус 401.14-4)



Масса не более 0,45 г

Нумерация выводов микросхем показана условно.

### ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц . . . . .	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	400 (40)

Механический удар:

одиночного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	10 000 (1000)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2

## МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 512

### Общие данные

многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц . . . . .	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ . . . . .	150
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст.)	
для микросхемы 512ПС10 . . . . .	$1,3 \cdot 10^{-4}$ ( $10^{-6}$ )
» остальных микросхем . . . . .	665 (5)
Атмосферное повышенное давление, атм . . . . .	
	3
Повышенная температура среды, °С:	
для микросхемы 512ПС10 . . . . .	100
» остальных микросхем . . . . .	85
Пониженная температура среды, °С . . . . .	
	минус 60
Изменения температуры среды, °С:	
для микросхемы 512ПС10 . . . . .	от минус 60 до +100
» остальных микросхем . . . . .	от минус 60 до +85
Повышенная относительная влажность при 35°С, %	
	98
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

### НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч . . . . .	50 000
Срок сохраняемости*, лет . . . . .	25

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11.073.041—82, ОСТ 11 073.040—82 и требованиями, изложенными ниже.

При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхемы в контактирующих устройствах замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Установка микросхем на платы при монтаже осуществляется вплотную или с зазором не более 0,7 мм с последующей прилакировкой или приклейкой.

Допускается установка микросхем с использованием прокладки, заполняющей зазор.

При всех режимах монтажа на платах температура на корпусе микросхемы не должна превышать предельно допустимую температуру.

\* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.